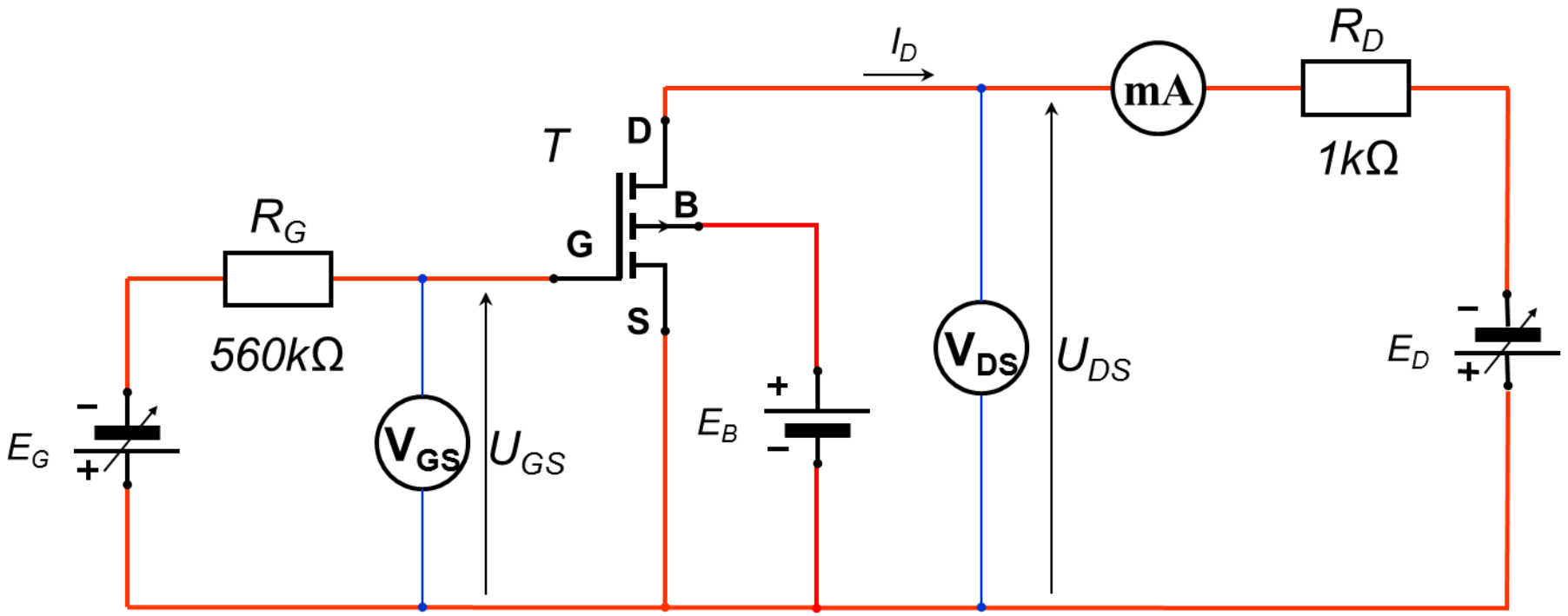
Badanie tranzystorów polowych MOSFET



Rys. 12. Układ do pomiaru statycznych charakterystyk tranzystora polowego MOS ze wzbogacanym kanałem typu **p**